

Title (en)

Plasma method for making a dielectric rod.

Title (de)

Plasmaverfahren zur Herstellung eines dielektrischen Stabes.

Title (fr)

Procédé à plasma pour la fabrication d'une tige diélectrique.

Publication

EP 0094053 A1 19831116 (DE)

Application

EP 83104464 A 19830506

Priority

DE 3217839 A 19820512

Abstract (en)

[origin: US4508554A] A plasma process for the production of a dielectric rod 6 from gaseous starting materials, causes the rod 6 to grow in the axial direction by deposition on its end face. This is effected by conducting microwave energy via the rod 6 to its end face, this energy maintaining a gaseous discharge 7 at the end face. The starting material flows into this gaseous discharge as a gaseous jet by means of a concentric nozzle system 8.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Plasmaverfahren zur Herstellung eines dielektrischen Stabes (6) aus gasförmigen Ausgangsmaterialien, bei dem der Stab (6) durch Abscheidung auf die Stirnfläche des Stabes (6) in Achsrichtung wächst, indem über den Stab (6) zu seiner Stirnfläche hin Mikrowellenenergie geleitet wird, die an der Stirnfläche eine Gasentladung (7) aufrechterhält, in welche mittels eines konzentrischen Düsensystems (8) das Ausgangsmaterial als Gasstrahl einströmt.

IPC 1-7

C03B 37/025; C03B 19/00

IPC 8 full level

H01J 37/32 (2006.01); **C03B 8/04** (2006.01); **C03B 19/00** (2006.01); **C03B 19/01** (2006.01); **C03B 19/14** (2006.01); **C03B 37/012** (2006.01); **C03B 37/014** (2006.01); **C03B 37/018** (2006.01); **C03B 37/025** (2006.01); **C23C 16/50** (2006.01); **C23C 16/511** (2006.01); **H05H 1/46** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C03B 19/01 (2013.01 - EP US); **C03B 19/1423** (2013.01 - EP US); **C03B 19/1476** (2013.01 - EP US); **C03B 37/01294** (2013.01 - EP US); **C03B 37/014** (2013.01 - EP US); **C03B 37/0142** (2013.01 - EP US); **C03B 37/0148** (2013.01 - EP US); **C03B 2207/06** (2013.01 - EP US); **C03B 2207/28** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] US 4135901 A 19790123 - FUJIWARA KUNIO, et al
- [Y] FR 2418777 A1 19790928 - HITACHI LTD [JP]
- [A] DE 2605483 A1 19770818 - LICENTIA GMBH
- [A] FR 2313327 A1 19761231 - QUARTZ & SILICE [FR]
- [XP] EP 0072069 A1 19830216 - PHILIPS NV [NL]

Cited by

GB2151609A; EP0263469A1; EP0257587A1; US4941905A; US6928839B2

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0094053 A1 19831116; EP 0094053 B1 19861015; DE 3217839 A1 19831117; DE 3366906 D1 19861120; JP S5922654 A 19840204; US 4508554 A 19850402

DOCDB simple family (application)

EP 83104464 A 19830506; DE 3217839 A 19820512; DE 3366906 T 19830506; JP 8183383 A 19830512; US 49384483 A 19830512